

○ 低周波電力増幅用

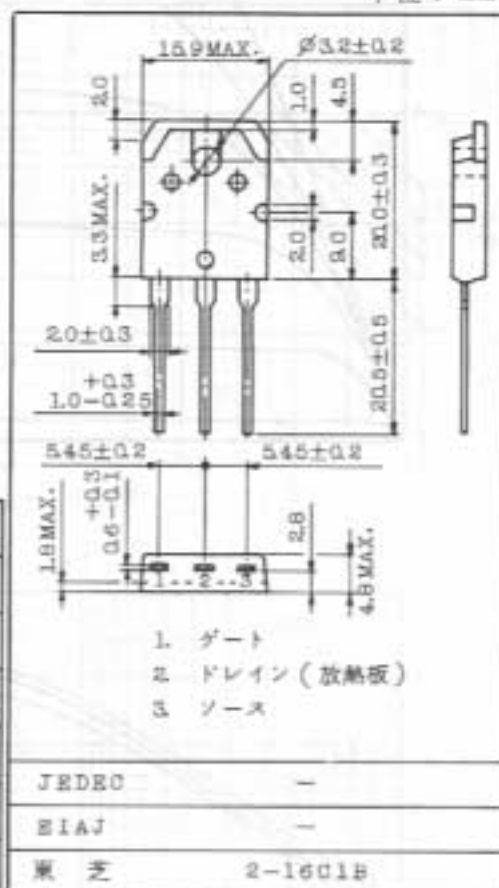
単位: mm

特 長

- ・ 高耐圧です。 : $V_{DSS} = -160V$
- ・ 高順方向伝達アドミタンスです。 : $|Y_{fs}| = 2.0S$ (標準)
- ・ 2SK405 とコンプリメンタリになります。

最大定格 ($T_a = 25^\circ C$)

項 目	記 号	定 格	単 位
ドレイン・ソース間電圧	V_{DSS}	-160	V
ゲート・ソース間電圧	V_{GSS}	± 20	V
ドレイン電流	I_D	-8	A
許容損失 ($T_c = 25^\circ C$)	P_D	100	W
チャネル温度	T_{ch}	150	$^\circ C$
保 存 温 度	T_{stg}	-55~150	$^\circ C$

電気的特性 ($T_a = 25^\circ C$)

項 目	記 号	測 定 条 件	最 小	標 準	最 大	単 位
ゲート漏れ電流	I_{GSS}	$V_{DS} = 0, V_{GS} = \pm 20V$	—	—	± 1.0	μA
ドレイン・ソース間降伏電圧	$V_{(BR)DSS}$	$I_D = -5mA, V_{GS} = 0$	-160	—	—	V
ゲート・ソース間しき断電圧	$V_{GS(OFF)}$ (注)	$V_{DS} = -10V, I_D = -0.1A$	-0.8	—	-2.8	V
ドレイン・ソース間飽和電圧	$V_{DS(ON)}$	$I_D = -5A, V_{GS} = -10V$	—	-3.5	-7.0	V
順方向伝達アドミタンス	$ Y_{fs} $	$V_{DS} = -10V, I_D = -2A$	1.0	2.0	—	S
入 力 容 量	C_{iss}	$V_{DS} = -10V, V_{GS} = 0, f = 1MHz$	—	800	—	pF
出 力 容 量	C_{oss}	$V_{DS} = -10V, V_{GS} = 0, f = 1MHz$	—	500	—	pF
母 還 容 量	C_{rs}	$V_{DS} = -10V, V_{GS} = 0, f = 1MHz$	—	110	—	pF

(注) $V_{GS(OFF)}$ 区分 0: -0.8~-1.6, Y: -1.4~-2.8